

物理電子システム創造専攻

平成17年度 修士構想(中間)発表会プログラム(案)

2005年12月12日版

会場: J2-J232

2005年12月20日

発表時間: 7分 質疑6分(中間発表: 10分+5分)

開始時間	研究室	名前	題名	審査員	司会
9:00	宗片研	小林 紘子	キャリア誘起強磁性に關与する磁性イオンの電氣的検出法の研究		
9:13	宗片研	信谷 和隆	強磁性半導体(GaMn)Asの高品質化に關する研究:Tcの上昇と発光		
9:26	大見研	佐藤 雅樹	PtSiFUSI/HfONゲートスタック構造の形成とSOI-MOSFETへの応用		
9:39	大見研	矢橋 健一	SBSIにより形成したSOI基板上への高誘電率ゲートMOSFETの作製		
9:52	半那研	中間 橋本 亮平	液晶性有機半導体を用いた有機EL素子の基礎研究		
10:07			休憩		
10:17	半那研	石松 祐輔	強誘電性を持つ液晶性有機半導体の電氣物性		
10:30	半那研	川島 学	ポリマー基質を用いた液晶製有機半導体薄膜の形成と評価		
10:43	浅田研	鈴木 左文	共鳴トンネルダイオードを用いたTHz帯発振素子の高出力化に向けた素子間相互注入同期		
10:56	浅田研	花島 君俊	共鳴トンネルダイオードを用いたTHz発振素子の高調波注入同期による周波数制御		
11:09			休憩		
11:19	浅田研	宮地 正人	InPショットキーバリアダイオードを用いたTHz帯ミキシング検出器に關する研究		
11:32	渡辺研	内田 薫	Plasmon導波路を用いた弗化物系サブバンド間遷移レーザに關する研究		
11:45	渡辺研	小平 新志	CdF2/CaF2超格子活性層を用いたサブバンド間遷移レーザに關する研究		
11:58	渡辺研	藤井 諒	メモリ応用に向けたSi(100)基板上弗化物系共鳴トンネルダイオードの研究		
12:11			休憩		
13:20	梶川研	尾崎 浩児	表面プラズモン光双安定デバイス		
13:33	梶川研	長山 哲哉	ドライプロセスを用いた金ナノ微粒子の作製		
13:46	石原研	梅山 将志	強誘電体ゲートトランジスタの低電圧化に關する研究		
13:59	石原研	齋藤 貢一	1T1D型強誘電体メモリセルの特性評価		
14:12	石原研	矢野 亜季	カーボンナノチューブを用いた強誘電体ゲートFETの製作		
14:25			休憩		
14:35	徳光研	高野 友一	上部絶縁体にHfAlOを用いたMIFIS構造キャパシタとデバイス応用に關する研究		
14:48	徳光研	畑山 智裕	有機金属化学氣相成長法により形成した絶縁膜/SiCの界面制御とデバイス応用に關する研究		
15:01	徳光研	藤村 朋史	強誘電体/ITO構造トランジスタの性能向上に關する研究		
15:14	小林研	城岸 直輝	光配線用面発光レーザの高速直接変調に關する研究		
15:27	小林研	多々良 裕基	光パケット信号の全光入力処理に關する研究		
15:40			休憩		
15:50	小林研	田中 紳公	吸収層最適化による面型変調器の低電圧・高速動作に關する研究		
16:03	小林研	盛田 琢也	導波路型全光スイッチの集積化に關する研究		
16:16	植之原研	岡本 健資	時間分離型多波長ラベル生成器に關する研究		
16:29	植之原研	高梨 雄介	半導体光増幅器の相互位相変調特性を用いたタイミング制御型光信号再生器に關する研究		
16:42	納富・小山研	佐々木 洋輔	負の屈折率を持つ二次元フォトニック結晶中での光伝搬特性に關する研究		

物理電子システム創造専攻

平成17年度 修士構想(中間)発表会プログラム(案)

会場：J2-J233

2005年12月20日

発表時間：7分 質疑6分（中間発表：10分+5分）

開始時間	研究室		名前	題名	審査員	司会
9:00	伊藤研		大井川 誠	冷却原子のスピン編極とスピクラスターの形成		
9:13	伊藤研		近藤 栄一郎	Bow-tie 原子トラップにおける近接場光誘起		
9:26	青柳研		清水 博史	深紫外発光素子用高品質AlGaIn形成に関する研究		
9:39	青柳研		藤森 文浩	有機薄膜トランジスタの短チャネル化		
9:52	青柳研		渡辺 恒介	非線形光学材料を用いたフォトニック結晶構造の作製と光機能デバイスへの応用		
10:05	休憩					
10:15	青柳研	中間	内田 剛生	ポイントコンタクトとカーボンナノチューブを用いたエレクトロメータの作製と評価		
10:30	筒井研		小林 勇介	FIN型電界効果トランジスタの高性能化プロセスの研究		
10:43	筒井研		齋藤 格広	Si集積化回路における多段直列共鳴トンネルデバイスに関する研究		
10:56	筒井研		濱島 英孝	SrxCd1-xF2混晶により格子整合したSi基板上弗化物共鳴トンネルデバイスの研究		
11:09	岩井研		椎野 泰洋	Novel Rare Earth Oxides Gate Stack for Advanced La2O3 MOSFET		
11:22	休憩					
11:32	岩井研		塩澤 崇史	Study of reliable Ni silicide integration processes for small scale CMOS		
11:45	岩井研		宋 在烈	A study on Process Optimization for Ge-based Electron Devices using Rare Earth high-k Gate Dielectric		
11:58	岩井研		舘 喜一	A Study on Process Optimization of High Performance La2O3Gate MISFET		
12:11	岩井研		中川 昌幸	High Frequency Model and Noise Characteristics of RF MOSFET		
12:24	休憩					
13:20	岩井研		永廣 侯治	Study of heat-resistive Ni silicide using co-deposition of various elements		
13:33	小山研		金澤 慈	高歪GaInAs/GaAsレーザの高温動作に関する研究		
13:46	小山研		北林 直人	面発光レーザアレイの多波長集積化に関する研究		
13:59	小山研		平野 豪	高Q値共振器を用いた面型光変調器		
14:12	宮本研		岩崎 鷹博	トンネル注入レーザの動作特性解明とMBEによる製作		
14:25	休憩					
14:35	宮本研		柏原 吉浩	MBE法による1.5 μ m帯GaInNAsSbレーザの形成に関する研究		
14:48	宮本研	中間	鈴木 亮一郎	MOCVD法によるGaInNAs系自己形成量子ドットとその長波長帯レーザへの応用に関する研究		
15:03	益研		伊藤 雄作	動的再構成可能広帯域CMOS RF発振器に関する研究		
15:16	益研		上蘭 巧	配線長分布に基づく集積回路の統計的性能評価手法の研究		
15:29	益研		川添 大輔	動的再構成可能CMOS RF回路の性能補償技術に関する研究		
15:42	休憩					
15:52	益研		木村 実人	40Gbps伝送を可能とする高密度伝送線路配線に関する研究		
16:05	益研		清田 淳紀	伝送線路を用いたオンチップ長距離高速信号伝送回路の研究		
16:18	益研		山内 拓弥	動的再構成可能広帯域CMOS無線回路の研究		